

半 导 体 学 报

第 7 卷 第 4 期 1986 年 7 月

目 录

- LEC 掺 In-GaAs 单晶中的一种新型缺陷.....何 晖 褚一鸣 林兰英 (341)
- 肖特基二极管导纳的研究及其在能级测量中的应用.....
.....高小平 周 洁 许振嘉 (346)
- 重申运动学低能电子衍射方法和 Si(001)2×1 结构.....赵汝光 杨威生 (357)
- n-Si 低剂量 B⁺、P⁺ 离子注入产生的缺陷及其退火特性
.....陈建新 李名复 李言谨 (363)
- CVD BPSG 膜的沉积及其回流机理曾天亮 江志庚 (374)
- 用计入相干势近似修正的 LCAO 方法计算合金的能隙变化.....陆 奋 (380)
- Si:Cr 中的 E 能级的计算.....王永良 (387)
- 质子注入直拉硅中缺陷的研究.....李灿国 姚秀琛 秦国刚 (397)
- 氧在 GaP(111) 表面上的吸附特性.....邢益荣 W.Ranke (407)
- LSIS-II 自动布图系统中的布局子系统程可行 庄文君 (412)
- B 样条函数器件插值模型在电路模拟程序 SPICE 中的应用
.....严志新 王碧娟 姚林声 (419)

研 究 简 报

- 由脉冲 MOS 结构的 I-C 瞬态曲线确定产生寿命的深度分布张秀森 (427)
- 氧在 a-GaAs(:H) 表面吸附的光电子谱研究.....汪兆平 (433)
- 氢气区熔硅单晶中的新红外吸收谱峰.....轩振国 张美蓉 游志朴 (437)
- 光电化学法测量 N 型半导体材料扩散长度.....邵永富 陈自姚 (441)
- 多晶硅膜的高压氧化.....张爱珍 王阳元 (446)

研 究 快 报

- GaAs-Al_xGa_{1-x}As DH 发光管的压力调频研究
.....赵学恕 李国华 汪兆平 韩和相 石志文 王丽明 唐汝明 (450)